(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2012 年 12 月 13 日 (13.12.2012)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2012/167565 A1

(51) 国际专利分类号:
H01L 21/00 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2011/082438

(22) 国际申请日: 2011 年 11 月 18 日 (18.11.2011)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
201110156346.7 2011 年 6 月 10 日 (10.06.2011) CN

(71) 申请人 (对除美国外的所有指定国): **北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 (BEIJING NMC CO., LTD.)** [CN/CN]; 中国北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号, Beijing 100176 (CN)。

(72) 发明人; 及

(75) 发明人/申请人 (仅对美国): **古村雄二 (FURUMURA, Yuji)** [JP/CN]; 中国北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号, Beijing 100176 (CN)。 **张建勇 (ZHANG, Jianyong)** [CN/CN]; 中国北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号, Beijing 100176 (CN)。 **张秀川 (ZHANG, Xiuchuan)** [CN/CN]; 中国北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号, Beijing 100176 (CN)。 **周卫国 (ZHOU, Weiguo)** [CN/CN]; 中国北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号, Beijing 100176 (CN)。

(74) 代理人: **北京天昊联合知识产权代理有限公司 (TEE & HOWE INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS)**; 中国北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 D 座 10 层张天舒, Beijing 100005 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

[见续页]

(54) Title: HEAT REFLECTING DEVICE AND SEMICONDUCTOR PROCESSING APPARATUS

(54) 发明名称 : 热反射装置及半导体处理设备

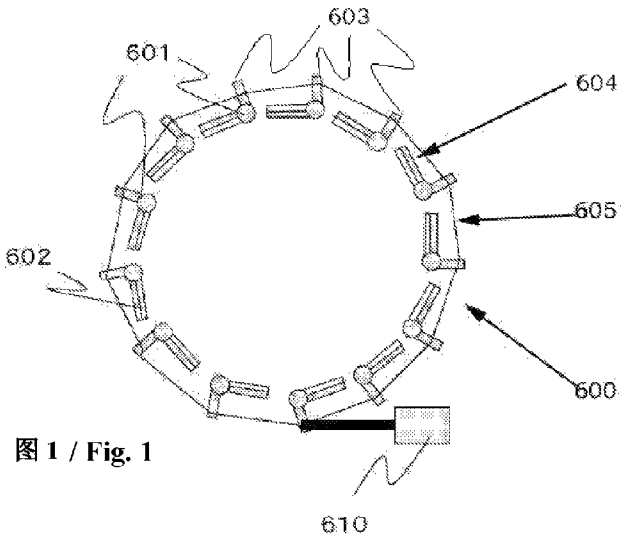


图 1 / Fig. 1

(57) Abstract: A heat reflecting device (600) using for a semiconductor processing apparatus is provided. The semiconductor processing apparatus comprises a process chamber, the heat reflecting device (600) comprises at least one heat reflecting unit (604), each heat reflecting unit (604) has a reflecting surface capable of reflecting heat. The heat reflecting device (600) is disposed in peripheral of the process chamber to reflect heat toward to the process chamber. A semiconductor process apparatus is also provided, the heat reflecting device (600) is disposed in peripheral of the process chamber of the semiconductor process apparatus.

(57) 摘要: 提供一种用于半导体处理设备的热反射装置（600）。半导体处理设备包括工艺腔室，热反射装置（600）包括至少一个热反射单元（604），每一个热反射单元（604）均具有可反射热量的反射面。热反射装置（600）设置在工艺腔室的外围，用以将热量朝向工艺腔室反射。还提供一种半导体处理设备，在其工艺腔室外围设置有该热反射装置（600）。

WO 2012/167565 A1

(84) **指定国** (除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第 21 条(3))。